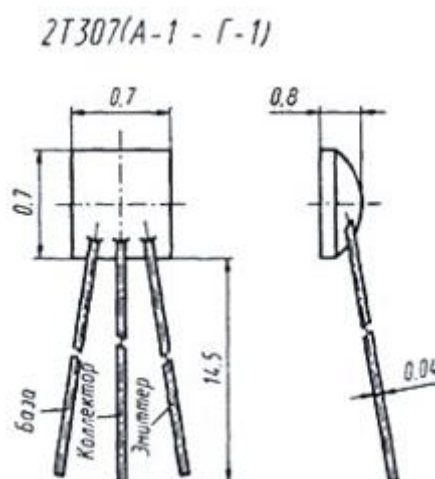


## 2Т307Г-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах.

Бескорпусные, без кристаллодержателя с гибкими выводами и защитным покрытием. Выпускаются в сопроводительной таре.



Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,002 г

Технические условия: СБО.336.026 ТУ.

Изготовитель - АО «Светлана», Санкт-Петербург.

### Основные технические характеристики транзистора 2Т307Г1 при $t=25^{\circ}\text{C}$ :

- $h_{21э}$  - Статический коэффициент передачи тока для схем с ОЭ: не менее 80;
- $f_{гр}$  - Граничная частота коэффициента передачи тока: не менее 300 МГц;
- $I_{кбо}$  - Обратный ток коллектора при  $U_{кб} = 10 \text{ В}$ : не более 0,5 мкА;
- $C_{к}$  - Емкость коллекторного перехода: не более 5 пФ;
- $U_{кб \text{ max}}$  - Максимальное напряжение коллектор-база: 10 В;
- $U_{кэг \text{ max}}$  - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{бэ} \leq 3 \text{ кОм}$ : 10 В;
- $U_{эбо \text{ max}}$  - Максимальное напряжение эмиттер-база: 4 В;
- $I_{к \text{ max}}$  - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 20 мА;
- $I_{к \text{ max}}$  - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 50 мА;
- $P_{к \text{ max}}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 15 мВт;
- $t_{окр}$  - температура окружающей среды:  $-60...+85^{\circ}\text{C}$ .